

FHT8050 APPROVAL SHEET

FHT8050 承认书

CUSTOMER NAME 客户名称: _____

PRODUCT NAME 产品名称: **SOT-23 三极管**

CUSTOMER PART NAME 客户型号: _____

FENGHUA PART NAME 风华型号: **FHT8050Y-E**

DATE 日期: **2008年10月21日**

CUSTOMER 客户			MANUFACTURER 制造商		
APPROVAL 承认			APPROVAL 承认		
DESIGNER 设计/开发	CHECKER 审核	APPROVER 批准	DESIGNER 拟制	CHECKER 审核	AUTHORITY 批准



广东风华高新科技股份有限公司

GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY(HOLDING) CO.,LTD

2008年第2版 All Rights Reserved



Low Frequency Power Amplifier Transistors 低频功率放大三极管

NPN Silicon (FHT8050)

FEATURES 特点

- Low Frequency Power Amplifier 低频功率放大
- Suitable for Driver Stage of Small Motor 小马达驱动
- Complementary to FHT8050 与 FHT8550 互补

MAXIMUM RATINGS($T_a=25^\circ\text{C}$) 最大额定值

CHARACTERISTIC 特性参数	Symbol 符号	Rating 额定值	Unit 单位
Collector-Base Voltage 集电极-基极电压	V_{CBO}	40	Vdc
Collector-Emitter Voltage 集电极-发射极电压	V_{CEO}	25	Vdc
Emitter-Base Voltage 发射极-基极电压	V_{EBO}	5.0	Vdc
Collector Current—Continuous 集电极电流-连续	I_C	800	mAdc
Base Current 基极电流	I_B	160	mAdc
Collector Power Dissipation 集电极耗散功率	P_C	300	mW
Junction Temperature 结温	T_j	150	$^\circ\text{C}$
Storage Temperature Range 储存温度	T_{stg}	-55~150	$^\circ\text{C}$

DEVICE MARKING 打标

$h_{FE}(1)$ FHT8050O=7O(85~200),FHT8050Y=7Y(160~300),FHT8050G=7G(280~360)
FHT8050D=7Y(200~350)

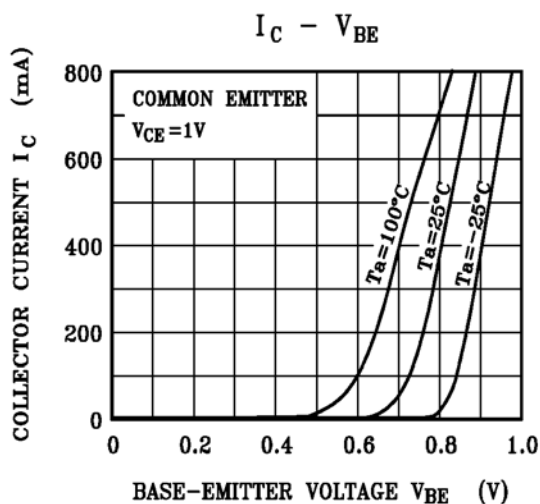
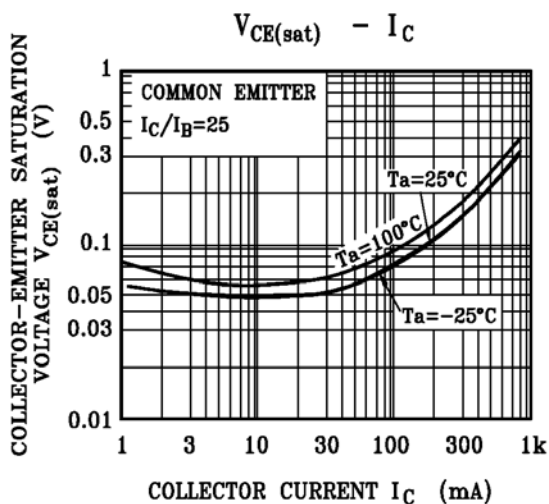
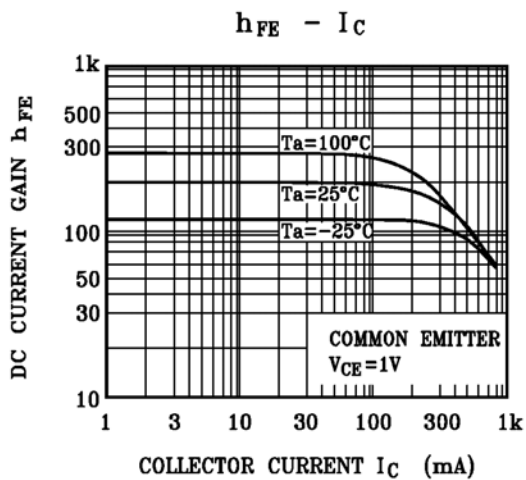
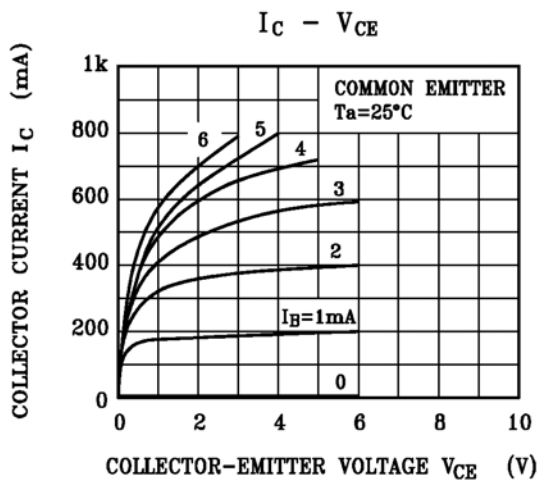
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电特性

($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为 25°C)

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Test Condition 测试条件	Min 最小值	TYP 典型	Max 最大值	Unit 单位
Collector Cutoff Current 集电极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB}=30V, I_E=0$	—	—	0.1	μA
Emitter Cutoff Current 发射极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB}=5V, I_C=0$	—	—	0.1	μA
Collector-Base Breakdown Voltage 集电极-基极击穿电压	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=100\mu\text{A}$	40	—	—	V
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集电极-发射极击穿电压	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=10\text{mA}$	25	—	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 发射极-基极击穿电压	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=100\mu\text{A}$	5	—	—	V
DC Current Gain 直流电流增益	$h_{FE}(1)$	$V_{CE}=1V, I_C=100\text{mA}$	85	—	360	—
	$h_{FE}(2)$	$V_{CE}=1V, I_C=800\text{mA}$	40	—	—	—
Collector-Emitter Saturation Voltage 集电极-发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=500\text{mA}, I_B=50\text{mA}$	—	—	0.6	V
Base-Emitter Voltage 基极-发射极电压	V_{BE}	$V_{CE}=1V, I_C=10\text{mA}$	—	0.8	1.0	V
Transition Frequency 特征频率	f_T	$V_{CE}=5V, I_C=10\text{mA}$	100	120	—	MHz
Collector Output Capacitance 输出电容	C_{ob}	$V_{CB}=10V, I_E=0, f=1\text{MHz}$	—	13	30	pF

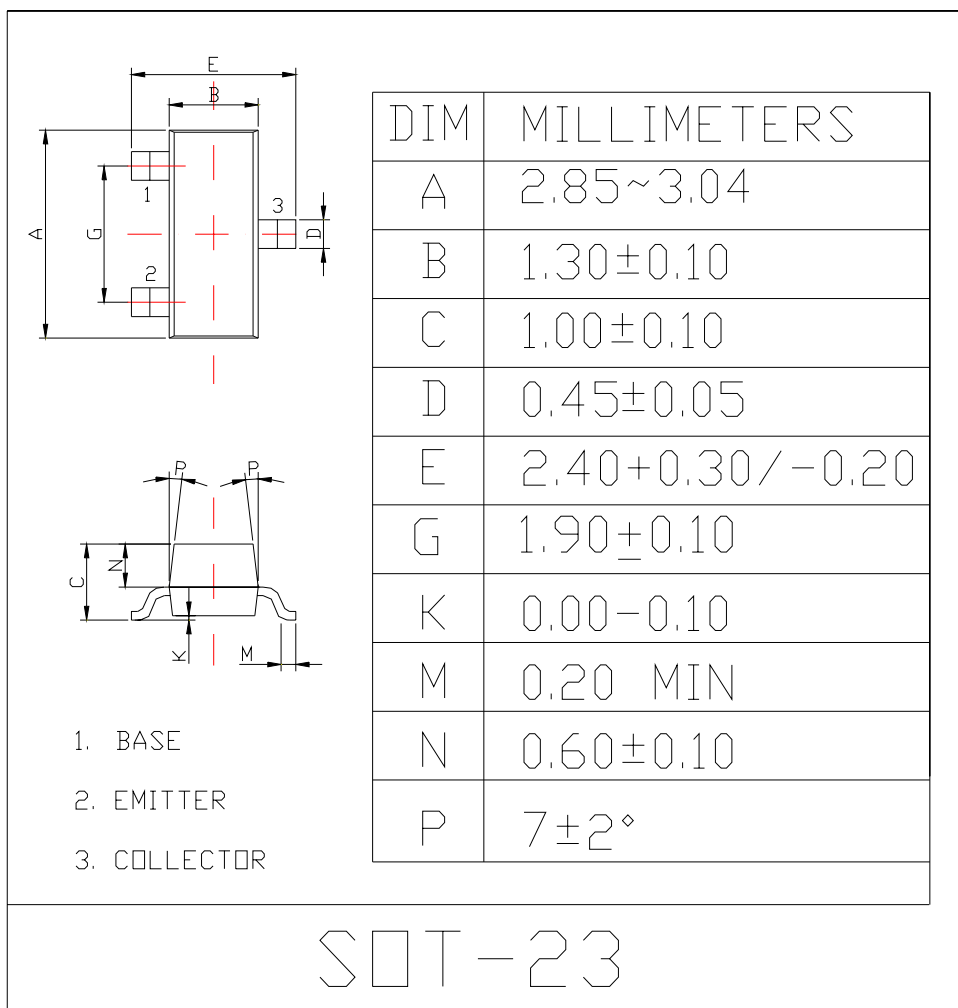
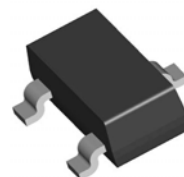


FHT8050





SOT-23 封装外形尺寸 (SOT-23 DIMENSION)



单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>FH\(风华高科\)](#)